

TAP650 Series

High-power, low profile design



FEATURES

- For variable speed drives, power supplies, control devices, robotics, motor control and other power designs.
- High-purity ceramic metalized with film on bottom for better heat transfer and optimum discharge.
- Encapsulation: Special resin-filled epoxy casing. High insulation resistance (CTI 600), high dielectric strength and partial discharge capability.
- Resistance Element: Special design for low inductance and capacitance values. The element demonstrates stability while covering high wattage and pulse load-ing.



CHARACTERISTICS

Power rating 650W at 85°C bottom case temp. (Please ask for detailed mounting procedure! This value is only applicable if using thermal conduction to the heat sink $R_{th-cs} < 0.117^\circ\text{K/W}$. This value can be obtained by using a thermal transfer compound with a heat conductivity of 8.55 W/mK. The flatness of the cooling plate must be better than 0.05mm overall. Surface roughness should not exceed 6.4µm.

Derating



Test Method	Typical results
Short time overload 1,000W/10sec	0.4%
Humidity steady state 56 days/40°C/95%	0.25%
Temp. cycling -55°/+125°/5 cycles	0.20%
Shock 40g/4,000 times	0.25%
Vibrations 2-500Hz/10g	0.25%
Load life 3,000cyl; Pn 30 min. on / 30 min off	0.40%

Resistance values	0.25Ω to 1MΩ (others upon request). Values below 1 ohm are measured at max lead length.
Resistance tolerance	±5% to ±10%
Temperature coefficient	±150 ppm/°C (others upon request)
Maximum working voltage	5,000VDC, higher voltage upon request, not exceeding max. power
Short time overload	1,000 W at 70°C for 10sec., delta-R = 0.4% max.
Power rating	650W at 85°C bottom case temperature (others upon request)
Peak current	up to 1,500A depending on pulse length and frequency. Please ask for details!
Electric strength voltage	6kVrms, 50 Hz, up to 12 kVrms upon special request.
Single shot voltage	up to 12kV norm wave (1.5/50 µsec)
Partial discharge	4kVrms, <10 pC, up to 7kV upon special request
Insulation resistance	10 GΩ min. at 500V
Inductance	80nH (typical)
Capacity/mass	110 pF
Capacity/parallel	40 pF
Operating temperature	res. body: -55°C to +150°C; std. cables: -40°C to +120°C (other cables upon request)
Mounting max. torque	1.8 Nm, M4 screws
Housing material	According to UL94-V0
Standard storage conditions	0° to 85°C at 80% RH max. for min. 12 months. For different conditions please contact factory
Derating (thermal resist.)	8.55W/°K (0.117°K/W)

(continued)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9